

SU 186/SU 187/SU 188



Si-npn-Leistungsschalttransistoren für Schaltnetzteile
und allgemeine Anwendung

Bauform 5 TO3

Wärmewiderstand $R_{thjc} \leq 1,17 \text{ K/W}$

Grenzwerte (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

	SU 186	SU 187	SU 188	
$U_{CBO} (I_E = 0)$	160	250	300	V
$U_{CEO} (I_B = 0)$	125	200	250	V
I_C	15	15	20	A
I_{CM}	20	20	25	A
$P_{tot} (\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C})$		150		W
ϑ_j	$-25 \dots +200$			$^\circ\text{C}$
ϑ_a	$-25 \dots +125$			$^\circ\text{C}$

Elektrische Kennwerte bei $\vartheta_c = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$

I_{CEX}	$(U_{CE} = U_{CBO}, U_{BE} = -2 \text{ V})$	$\leq 1,0$	mA
U_{CEsat}	$(I_C = 5 \text{ A}, I_B = 0,5 \text{ A})$	$\leq 1,5$	(SU 186) V
U_{CEsat}	$(I_C = 8 \text{ A}, I_B = 0,8 \text{ A})$	$\leq 1,6$	(SU 187) V
U_{CEsat}	$(I_C = 10 \text{ A}, I_B = 1,25 \text{ A})$	$\leq 1,5$	(SU 188) V
t_f	$(I_C = 5,0 \text{ A}, I_B = 0,5 \text{ A}, -I_B = 1,0 \text{ A})$	$\leq 1,0$	(SU 186) μs
t_f	$(I_C = 8,0 \text{ A}, I_B = 0,8 \text{ A}, -I_B = 1,6 \text{ A})$	$\leq 0,8$	(SU 187) μs
t_f	$(I_C = 10 \text{ A}, I_B = 1,25 \text{ A}, -I_B = 2,5 \text{ A})$	$\leq 0,7$	(SU 188) μs